
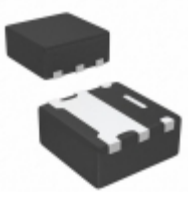
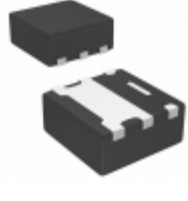
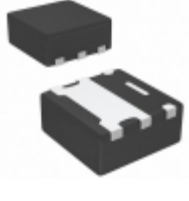

	<h2>SIB414DK-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIB414DK-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIB414DK-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIB414DK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	12000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 8V 9A (Tc) 2.4W (Ta), 13W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 13W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 7.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.03nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	732pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIB414DK-T1-GE3TR

SIB414DK-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB414DK-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB414DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB414DK-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIB414DK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6</p>	 <p><b>SIB417AEDK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A PWRPACK</p>	 <p><b>SIB415DK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB413DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>
 <p><b>SIB415DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB413DK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB417AEDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A PWRPACK</p>	 <p><b>SIB412DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6</p>

### heiße Teile

Mehr

08051A271GAT2A	22255A153KAT2A	6SY7010-0AB51	ACB82202	BGS22WL10
BH7606GU-E2	BK60A-300L-050F30G	C3216X7T2J473M160AE	CM1300-03CS	DKI10526
EFCH1842TDB1	GP1S96J0000F	GR731BW0BB333KW01L	GRM0335C1E6R8DD01J	GRM1555C1E360JA01D
GRM1555C1H1R8BA01J	GRM1886T1H470JD01D	IR21366STRPBF	IRKH26-16	LT3472EDD#TR
MAX752CWE-T	MJD340-13	MLF1608DR47JT000	MP1907GQ-LF-Z	NTD4810N-1G
PKGS-00ME4-R	PKV5321PI	S-1323B18NB-N8DTEG	SBR20A50CT	SC370768DWR2
SI1417EDH-T1-GE3	SIB414DK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3	SIB437EDKT-T1-GE3
SIB437EDKT-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB911DK-T1-GE3	SIB911DK-T1-GE3
SIBA 10.NH000	SIHFR320-E3	ST7078-001	TPS2330IPWRG4	TPS54160AQDGSRDN
TST20U60C	UPD16835AGS-BGG	VE-J42-MZ	VI-2W0-08	WG8058S

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited